

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

УТВЕРЖДЕНО

**Директор физтех-школы физики
и исследований им. Ландау
А.В. Рогачев**

	Рабочая программа дисциплины (модуля)
по дисциплине:	Оптика наноструктур
по направлению:	Материаловедение и технологии материалов
профиль подготовки:	Перспективные функциональные материалы Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики кафедра квантовых наноструктур, материалов и устройств
курс:	1
квалификация:	магистр

Семестр, формы промежуточной аттестации: 1 (осенний) - Экзамен

Аудиторных часов: 60 всего, в том числе:

лекции: 30 час.

семинары: 30 час.

лабораторные занятия: 0 час.

Самостоятельная работа: 45 час.

Подготовка к экзамену: 30 час.

Всего часов: 135, всего зач. ед.: 3

Программу составил: А.Б. Ваньков, канд. физ.-мат. наук

Программа обсуждена на заседании кафедры квантовых наноструктур, материалов и устройств 23.04.2025

Аннотация

В курсе рассматриваются различные аспекты оптики твердого тела, важные для конструирования оптических наноструктур и количественного прогнозирования их откликов. Рассматриваются особенности металлических и полупроводниковых структур, соответствующие спектры отражения, пропускания, рассеяния и люминесценции. Обсуждаются принципы, на основе которых функционируют соответствующие сенсоры, генераторы и детекторы.

В финале курса студентам предлагаются задачи, решения которых разбираются на семинарах. Занятия проводятся в Черноголовке, на территории наукоемкой компании Раммикс, выпускающей оптические приборы.

1. Цели и задачи

Цель дисциплины

Целью дисциплины «Оптика наноструктур» является формирование базовых знаний по спектроскопии полупроводниковых и металлических наноструктур для дальнейшего использования в физике конденсированного состояния и других смежных дисциплинах естественнонаучного содержания; формирование кругозора в физике низкоразмерных систем, исследовательских навыков и способности применять знания на практике.

Задачи дисциплины

- формирование у обучающихся базовых знаний по физике низкоразмерных электронных систем;
- формирование базовых знаний по оптическим методам исследования свойств наноструктур;
- формирование умений и навыков применять полученные знания для решения задач в физике наноструктур и взаимодействии света с электронной подсистемой твердых тел, самостоятельного анализа полученных результатов.

2. Перечень формируемых компетенций

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
ПК-1 Способен ставить, формализовывать и решать задачи, в том числе разрабатывать и исследовать математические модели изучаемых явлений и процессов, системно анализировать научные проблемы, получать новые научные результаты	ПК-1.1 Способен находить, анализировать и обобщать информацию об актуальных результатах исследований
	ПК-1.3 Способен применять теоретические и (или) экспериментальные методы исследований к конкретной научной задаче и интерпретировать полученные результаты

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать:

- основные определения физики конденсированного состояния;
- характеристики энергетического спектра носителей в системах различной размерности (3,2,1,0), законы дисперсии электронов в полупроводниковых наноструктурах различного типа;
- гамильтониан взаимодействия электромагнитной волны с электронной системой, вывод соотношений для вероятности межзонного и межподзонных оптических переходов электронов в кристаллах, правила отбора для таких переходов;
- принципы оптической ориентации спинов носителей в полупроводниковых структурах;
- дисперсионные соотношения и параметры связанных состояний для экситонов Ванье-Мотта в полупроводниках, представление об экситонных поляритонах;
- идею и отличительные свойства основных оптических методик – фотолюминесценции, неупругого рассеяния света, спектроскопии поглощения;
- основные соотношения теории Ми для поверхностных резонансов металлических наночастиц, механизм усиления рамановского рассеяния света на металлических наночастицах;
- основные методы исследования полупроводниковых квантовых точек.

уметь:

- решать одночастичные задачи об энергетическом спектре электронов в низкоразмерных системах;
- выводить законы дисперсий квазичастиц в периодических сверхрешетках;
- выводить аналитические выражения для диэлектрической функции полупроводниковых кристаллов в области межзонных и межподзонных переходов;
- анализировать поведение коэффициента оптического поглощения в окрестности особых точек энергетического спектра электронных зон;
- вычислять порог оптического поглощения для полупроводниковых наноструктур разной размерности в зависимости от основных зонных параметров;
- выводить соотношения для коэффициента поверхностного усиления рамановского рассеяния на сферических металлических наночастицах.

владеть:

- математическим аппаратом квантовой механики электронов в кристаллических структурах;
- математическим аппаратом электродинамики.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№	Тема (раздел) дисциплины	Трудоемкость по видам учебных занятий, включая самостоятельную работу, час.			
		Лекции	Семинары	Лаборат. работы	Самост. работа
1	Размерное квантование	4	4		6
2	Оптические переходы между зонами и подзонами	4	4		6
3	Связь оптических констант с зонными параметрами полупроводника	4	4		6
4	Экситоны и магнитоэкситоны	3	3		6
5	Экситонные поляритоны	3	3		6
6	Фотолюминесценция полупроводников. Принципы оптической ориентации спинов носителей. Неупругое рассеяние света.	4	4		6
7	Оптические резонансные свойства металлических наночастиц	4	4		6
8	Оптические методы исследования квантовых точек	4	4		3
Итого часов		30	30		45

Подготовка к экзамену	30 час.
Общая трудоёмкость	135 час., 3 зач.ед.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Семестр: 1 (Осенний)

1. Размерное квантование

Композитные полупроводниковые материалы. Гетероструктуры. Гетеропереходы I и II рода. Квантовая яма. Квантовый барьер. Квантовая проволока. Квантовая точка. Сверхрешетка. Низкоразмерные электронные и дырочные системы. Уравнение Шредингера в приближении эффективной массы. Блоховская волновая функция электрона. Граничное условие Бастарда. Размерное квантование энергетического спектра. Подзона размерного квантования. Метод матриц переноса. Энергетический спектр электронов в периодической сверхрешетке. Нормальные и соленоидальные электромагнитные поля в оптических сверхрешетках. Поверхностные поляритоны.

2. Оптические переходы между зонами и подзонами

Плотность энергетических состояний носителей в системах различной размерности. Гамильтониан взаимодействия света с электронной системой. Вероятность перехода электрона между состояниями под действием света. Законы сохранения и правила отбора при оптических межзонных и внутризонных переходах электронов в полупроводниковых кристаллах. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Связь коэффициента экстинкции с полной вероятностью оптических переходов. Соотношения Крамерса-Кронига.

3. Связь оптических констант с зонными параметрами полупроводника

Дипольно разрешенные и запрещенные оптические переходы. Связь полной вероятности оптического перехода с комбинированной плотностью состояний. Аналитическое поведение оптических констант вблизи особых точек энергетического спектра электронов. Особенности Ван-Хова. Точки минимума, максимума и седловые точки. Связь спектра межзонного и межподзонного поглощения с особенностями зонной структуры полупроводника. Переходы между минизонами в сверхрешетках.

4. Экситоны и магнитоэкситоны

Экситоны Ванье-Мотта. Объемные, двумерные и квазидвумерные экситоны. Боровский радиус трехмерных и двумерных экситонов. Энергия связи и дисперсия экситонов. Экситонный вклад в спектр межзонного поглощения полупроводника. Магнитоэкситоны. Диамагнитный сдвиг энергии экситонов. Диамагнитные экситоны. Энергия связи диамагнитных экситонов. Экситонные эффекты в спектрах отражения и пропускания. Отражение света от одиночной квантовой ямы вблизи экситонного резонанса.

5. Экситонные поляритоны

Концепция экситонных поляритонов. Экситонные поляритоны в структурах с периодическим набором квантовых ям. Брэгговские зеркала. Квантовые микрорезонаторы. Дисперсия фотонов в квантовом микрорезонаторе. Частота Раби для экситонных поляритонов. Закон дисперсии двумерных экситонных поляритонов. Представление о Бозе-Эйнштейновской конденсации двумерных экситонных поляритонов.

6. Фотолюминесценция полупроводников. Принципы оптической ориентации спинов носителей. Неупругое рассеяние света.

Представление о спектроскопии фотолюминесценции твердых тел. Принципы оптической ориентации спинов свободных носителей в полупроводниках. Матричные операторы возмущения циркулярно поляризованным светом для межзонных оптических переходов. Уравнения кинетики для стационарного фотовозбуждения спиновых подсистем носителей. Степень спиновой поляризации. Время жизни ориентированного спина фотоэлектрона. Стационарный и нестационарный эффект Ханле. Понятие о неупругом рассеянии света. Законы сохранения в процессе рассеяния света. Осцилляторная модель рассеяния света. Двойной оптический резонанс. Изучение закона дисперсии квазичастиц методом неупругого рассеяния света.

7. Оптические резонансные свойства металлических наночастиц

Неупругое рассеяние света на молекулярных колебаниях. Феноменология эффекта поверхностно-усиленного рамановского рассеяния (SERS). Резонансы Ми. Электромагнитный и химический механизмы усиления SERS. Эффекты формы и размера. Локализованные поверхностные плазмоны. Связь усиления ближнего поля с параметрами металла. Применения SERS.

8. Оптические методы исследования квантовых точек

Размерное квантование электронных и фононных возбуждений квантовых точек. Поглощение света и фотолюминесценция квантовых точек.

Оптические методы исследования ансамблей квантовых точек. Экспериментальные методики исследования одиночных квантовых точек. Применения квантовых точек. Спектральные маркеры на квантовых точках.

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебная аудитория, оснащенная мультимедиапроектором и экраном.

6. Перечень рекомендуемой литературы

Основная литература

Литература выдается на базовой кафедре:

1. Оптические свойства наноструктур / Л. Е. Воробьев [и др.] ; под общ. ред. В. И. Ильина, А. Я. Шика. - СПб.: Наука, 2001

Дополнительная литература

Литература выдается на базовой кафедре:

1. Оптика наноструктур / под ред. А.В. Федорова. - СПб.: «Недра», 2005

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

<https://mipt.ru/education/chairs/kvantovye-nanostrukтуры-materialy-i-ustroystva/obrazovanie/optika-na-nostruktur.php>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Не предусмотрены.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Студент, изучающий курс «Оптика наноструктур», должен с одной стороны, овладеть общим понятийным аппаратом, а с другой стороны, должен научиться применять теоретические знания на практике.

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные определения физики твердого тела, понятия и методики оптической спектроскопии, способы вычисления энергетического спектра размерно-квантованных состояний в наноструктурах различной размерности, уравнения Шредингера для электрона в периодическом потенциале кристалла и его модификацию в присутствии электромагнитного возмущения; уметь исследовать поведение основных оптических характеристик полупроводников вблизи особых точек энергетического спектра электронов, уметь оценивать определяющие энергетические параметры задач об электронах и экситонах в наноструктурах в присутствии внешних полей, применять полученные знания для решения различных задач в области спектроскопии наноразмерных объектов.

Успешное освоение курса требует напряжённой самостоятельной работы студента. В программе курса приведено минимально необходимое время для работы студента над темой. Самостоятельная работа включает в себя:

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения, доказательство отдельных утверждений, свойств;
- решение задач, предлагаемых студентам на лекциях и практических занятиях;
- подготовку к практическим занятиям, коллоквиумам, экзамену.

Руководство и контроль за самостоятельной работой студента осуществляется в форме индивидуальных консультаций.

Показателем владения материалом служит умение решать задачи. Для формирования умения применять теоретические знания на практике студенту необходимо решать как можно больше задач. При решении задач каждое действие необходимо аргументировать, ссылаясь на известные теоретические сведения. Значительно облегчить решение задачи может предварительная оценка основных энергетических параметров рассматриваемой наноструктуры или другого материала, а также решение задачи в нулевом и первом порядках теории возмущений для оценки масштаба эффекта и целесообразности учета малых поправок для ответа.

При подготовке к практическим занятиям необходимо повторять ранее изученные основные определения, формулировки теорем. В начале занятия, как правило, проводится короткий (10 минут) опрос по материалу прошедших занятий в устной форме. Обычно придерживаются следующей схемы: изучение материала лекции по конспекту в тот же день, когда была прослушана лекция (10-15 минут); повторение материала накануне следующей лекции (10-15 минут), проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной литературе, подготовка ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения (1 час неделю), подготовка к практическому занятию, решение задач (1 час). Важно добиться понимания изучаемого материала, а не механического его запоминания. При затруднении изучения отдельных тем, вопросов, следует обращаться за консультациями к лектору или прибегнуть к более детальной проработке специализированной научной литературы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

по направлению:	Материаловедение и технологии материалов
профиль подготовки:	Перспективные функциональные материалы Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики кафедра квантовых наноструктур, материалов и устройств
курс:	<u>1</u>
квалификация:	магистр
Семестр, формы промежуточной аттестации: 1 (осенний) - Экзамен	
Разработчик:	А.Б. Ваньков, канд. физ.-мат. наук

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
ПК-1 Способен ставить, формализовывать и решать задачи, в том числе разрабатывать и исследовать математические модели изучаемых явлений и процессов, системно анализировать научные проблемы, получать новые научные результаты	ПК-1.1 Способен находить, анализировать и обобщать информацию об актуальных результатах исследований
	ПК-1.3 Способен применять теоретические и (или) экспериментальные методы исследований к конкретной научной задаче и интерпретировать полученные результаты

2. Показатели оценивания компетенций

В результате изучения дисциплины «Оптика наноструктур» обучающийся должен:

знать:

- основные определения физики конденсированного состояния;
- характеристики энергетического спектра носителей в системах различной размерности (3,2,1,0), законы дисперсии электронов в полупроводниковых наноструктурах различного типа;
- гамильтониан взаимодействия электромагнитной волны с электронной системой, вывод соотношений для вероятности межзонного и межподзонных оптических переходов электронов в кристаллах, правила отбора для таких переходов;
- принципы оптической ориентации спинов носителей в полупроводниковых структурах;
- дисперсионные соотношения и параметры связанных состояний для экситонов Ванье-Мотта в полупроводниках, представление об экситонных поляритонах;
- идею и отличительные свойства основных оптических методик – фотолюминесценции, неупругого рассеяния света, спектроскопии поглощения;
- основные соотношения теории Ми для поверхностных резонансов металлических наночастиц, механизм усиления рамановского рассеяния света на металлических наночастицах;
- основные методы исследования полупроводниковых квантовых точек.

уметь:

- решать одночастичные задачи об энергетическом спектре электронов в низкоразмерных системах;
- выводить законы дисперсий квазичастиц в периодических сверхрешетках;
- выводить аналитические выражения для диэлектрической функции полупроводниковых кристаллов в области межзонных и межподзонных переходов;
- анализировать поведение коэффициента оптического поглощения в окрестности особых точек энергетического спектра электронных зон;
- вычислять порог оптического поглощения для полупроводниковых наноструктур разной размерности в зависимости от основных зонных параметров;
- выводить соотношения для коэффициента поверхностного усиления рамановского рассеяния на сферических металлических наночастицах.

владеть:

- математическим аппаратом квантовой механики электронов в кристаллических структурах;
- математическим аппаратом электродинамики.

3. Перечень типовых (примерных) вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

1. Сформулируйте принципы интерпретации спектров люминесценции полупроводниковых квантовых точек.
2. Объясните механизм усиления рамановских спектров поверхностью плазмонных наноструктур.
3. Охарактеризуйте экситонные эффекты в спектрах отражения и пропускания.
4. Опишите влияние электромагнитного возмущения на электрон в периодическом потенциале кристалла.

5. Охарактеризуйте метод расчета комбинированной плотности состояний оптических переходов.

4. Перечень типовых (примерных) вопросов и тем для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Перечень примерных вопросов:

1. Композитные полупроводниковые материалы. Гетероструктуры. Гетеропереходы I и II рода. Квантовая яма. Квантовый барьер. Квантовая проволока. Квантовая точка. Сверхрешетка.
2. Концепция экситонных поляритонов. Экситонные поляритоны в структурах с периодическим набором квантовых ям. Брэгговские зеркала. Квантовые микрорезонаторы. Дисперсия фотонов в квантовом микрорезонаторе
3. Низкоразмерные электронные и дырочные системы. Уравнение Шредингера в приближении эффективной массы. Блоховская волновая функция электрона. Граничное условие Бастарда. Размерное квантование энергетического спектра.
4. Частота Раби для экситонных поляритонов. Закон дисперсии двумерных экситонных поляритонов. Представление о Бозе-Эйнштейновской конденсации двумерных экситонных поляритонов.
5. Характеристики энергетического спектра носителей в системах различной размерности (3,2,1,0), законы дисперсии электронов в полупроводниковых наноструктурах различного типа.
6. Гамильтониан взаимодействия электромагнитной волны с электронной системой, вывод соотношений для вероятности межзонного и межподзонных оптических переходов электронов в кристаллах, правила отбора для таких переходов.
7. Принципы оптической ориентации спинов носителей в полупроводниковых структурах.
8. Дисперсионные соотношения и параметры связанных состояний для экситонов Ванье-Мотта в полупроводниках,
9. Идея и отличительные свойства основных оптических методик – фотолюминесценции, неупругого рассеяния света, спектроскопии поглощения.
10. Основные соотношения теории Ми для поверхностных резонансов металлических наночастиц, механизм усиления рамановского рассеяния света на металлических наночастицах.

Примеры билетов:

Билет 1.

1. Композитные полупроводниковые материалы. Гетероструктуры. Гетеропереходы I и II рода. Квантовая яма. Квантовый барьер. Квантовая проволока. Квантовая точка. Сверхрешетка.
2. Концепция экситонных поляритонов. Экситонные поляритоны в структурах с периодическим набором квантовых ям. Брэгговские зеркала. Квантовые микрорезонаторы. Дисперсия фотонов в квантовом микрорезонаторе

Билет 2.

1. Низкоразмерные электронные и дырочные системы. Уравнение Шредингера в приближении эффективной массы. Блоховская волновая функция электрона. Граничное условие Бастарда. Размерное квантование энергетического спектра.
2. Частота Раби для экситонных поляритонов. Закон дисперсии двумерных экситонных поляритонов. Представление о Бозе-Эйнштейновской конденсации двумерных экситонных поляритонов.

Критерии оценивания

Оценка "отлично" (10 баллов) выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины, проявляющему интерес к данной предметной области, продемонстрировавшему умение уверенно и творчески применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка "отлично" (9 баллов) выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка "отлично" (8 баллов) выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, правильное обоснование принятых решений, с некоторыми недочётами.

Оценка "хорошо" (7 баллов) выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но недостаточно грамотно обосновывает полученные результаты.

Оценка "хорошо" (6 баллов) выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности.

Оценка "хорошо" (5 баллов) выставляется студенту, если он в основном знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач достаточно большое количество неточностей.

Оценка "удовлетворительно" (4 балла) выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он освоил основные разделы учебной программы, необходимые для дальнейшего обучения, и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка "удовлетворительно" (3 балла) выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, допускающему ошибки в формулировках базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, слабо владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и с трудом применяет полученные знания даже в стандартной ситуации.

Оценка "неудовлетворительно" (2 балла) выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных принципов и не умеет использовать полученные знания при решении типовых задач.

Оценка "неудовлетворительно" (1 балл) выставляется студенту, который не знает основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубейшие ошибки в формулировках базовых понятий дисциплины и вообще не имеет навыков решения типовых практических задач.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

При проведении оценивания знаний обучающемуся предоставляется время на подготовку на усмотрение экзаменатора.

Опрос обучающегося по билету не должен превышать одного астрономического часа.

Оценивание знаний производится в соответствии с вышеуказанными критериями в соответствии с содержанием дисциплины.